

**КТ8229А**

п-р-п кремниевый  
эпитаксиально-планарный  
биполярный транзистор

**Назначение**

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы. Предназначены для применения в ключевых и линейных схемах, а также в узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

**Зарубежные прототипы**

- прототип – TIP35F

**Особенности**

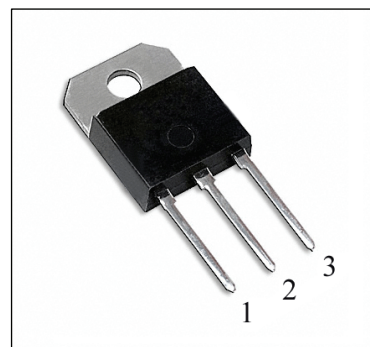
- диапазон рабочих температур от - 60 до + 125°С
- комплиментарная пара – КТ8230А

**Обозначение технических условий**

- АДБК.432.140.824 ТУ

**Корпусное исполнение**

- пластмассовый корпус КТ-43 (ТО-218)

**Назначение выводов**

Вывод	Назначение
№1	База
№2	Коллектор
№3	Эмиттер

**Таблица 1. Основные электрические параметры КТ8229А при  $T_{окр. среды} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$** 

Параметры	Обозн.	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо гр.	В	Iк=-30mA, Iб=0	180	
Обратный ток коллектора	Iкэо	mA	Uкэ=-120В, Iб=0		1,0
Обратный ток коллектора	Iкэк	mA	Uкэ=-180В, Uэб=0В		0,7
Обратный ток эмиттера	Iэбо	mA	Uэб=-5,0В, Iк=0		0,7
Статический коэффициент передачи тока	h21E		Uкэ=-4В, Iк=-1,5А Uкэ=-4В, Iк=-15А	25 15	75
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ(нас)	В	Iк=-15А, Iб=-1,5А Iк=-25А, Iб=-5,0А		1,8 4,0
Напряжение насыщения база-эмиттер	Uбэ(нас)	В	Iк=-15А, Iб=-1,5А Iк=-25А, Iб=-5,0А		2,0 4,0
Граничная частота коэффициента передачи тока	fгр.*	МГц	Iк=-1,0А, Uкэ=-10В	3,0	

**Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ8229А**

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	Uкб max	В	180
Напряжение коллектор-эмиттер:	Uкэо max	В	180
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Iк max	А	25
Постоянный ток базы	Iб max	А	5
Импульсный ток коллектора ( $t_u \leq 10\text{ мс}$ , $Q \geq 100$ )	Iки max	А	40
Постоянный ток базы	Iб max	А	5,0
Рассеиваемая мощность коллектора:	Pк max	Вт	125
Температура перехода	Tj	$^{\circ}\text{C}$	150
Тепловое сопротивление переход-корпус	Rt пер-корп.	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	1,0